PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

57189356 A

(43) Date of publication of application: 20.11.82

(51) Int. CI

G11B 7/24

(21) Application number: 56072647 (22) Date of filing: 14.05.81

(71) Applicant:

SONY CORP

(72) Inventor:

KOYAMA TOMOYA

AOKI YOSHIO WATANABE KENJIRO

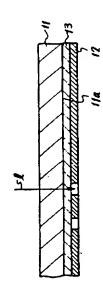
(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce recording power by forming a recording layer to be formed with recording pits by melting through a heat insulating material layer on a substrate.

CONSTITUTION: A substrate 1 having a smooth surface 11a is provided by a resin or glass, and an information recording layer 12 with 50W1000Å thicknesses consisting of a low m.p. metal consisting of an alloy contg. Bi, Te or at least one of these or an alloy consisting essentially of these and contg. In, Sb, Sn, Pb, etc. is deposited via a heat insulating material layer 13 on said surface 11a. A material layer 13 having a high transmittance to semiconductor laser light (I), having heat resistant to temp. during recording of the layer 12 and possessing high heat conductivity and a heat insulation effect is selected for the layer 13.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COFT

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—189356

⑤ Int. Cl.³G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 7247-5D ❸公開 昭和57年(1982)11月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全4 頁)

50情報記錄媒体

20特

願 昭56-72647

②出 願 昭56(1981)5月14日

⑫発 明 者 小山朝哉

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 青木芳夫

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 渡辺健次郎

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑪出 願 入 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

個代 理 人 弁理士 伊藤貞

外2名

明 細 看

発明の名称 情報配録媒体

特許請求の範囲

基体上に、光透過性断熱材層を介して低融点金 異より成る情報配録層が形成された情報配録媒体。 発明の詳細な説明

本発明は光学式の反射型或いは透過型ピデオディスク、デジタルオーディオディスク等に適用して好資な情報記録媒体に係わる。

通常の光学式の反射型或いは透過型ビデオデイスク、デジタルオーデイオデイスク等の情報配録 体体においては、一般ユーザーはそのデイスクド 記録された情報を読み出すのみの使用意様をとつ ている。

しかしながら、一般ユーザーにおいて、その様 体、例えばディスクに任意の情報を書き込むこと のできる配録可能な情報配録媒体も提案されてい る。このような配録可能な情報配録媒体としては、 例えば第1図に示すように、アクリル樹脂等の通 明著板(I)上に記録材料層(2)として厚さが200% 根 度の薄い低融点金属膜、例えばピスマス Bi、テル ル Te 等の膜を被着し、これにレーザー光!を記録 情報信号に応じて照射してこれを溶融させ、この 落融部において透孔ないしは凹部、 すなわち配録 ピットを形成してその記録を行うものがある。と とろがとのような構成による記録媒体においては、 その記録ピットの形成時に、その熱によつて基体 (1)も、とのピットの形成部が搭融され、記録ピッ トの周辺部に盛り上りが生じたり、ピット形状に 乱れを生じたりする。一方、基体(I) として耐熱性 にすぐれたガラス基体を用いるととが考えられる がこの場合は、基体(1)の熱伝導率が比較的高いた めに、ピットを形成するための熱が基体(1) 個に逃 げあく、大きな記録パワーしたがつて大エネルギ ーのレーサー旗を必要とするという欠点がある。 本発明は、とのような欠点を回避し、十分低い

記録パワーで情報の記録を行うととができるよう にした情報記録媒体を提供するものである。

すなわち、本発明にかいては、例えば第2図に 示すように、樹脂例えば PMMA(メタクリル酸エ

持開配57-189356(2)

ステル樹脂)、或いはガラス等より成り平層面 (11a)を有する基体側を設け、この面 (11a) に、 Bi , Te もしくはこれらの少くとも一種を含む合金、またはこれらを主体とし、 In , 8b , 8n , Pb 等を含む合金等より成る低融点金属より成り、厚さが 50%~1000%の情報配録層02を、 等に断熱 材料 03を介して被増する。

この情報配録層02に対する情報の配録は、基体 01)例から記録光、例えば波長8000 Åの半導体レーザー光 & を記録情報に応じて照射することによって行う。

断熱材層のは、この配母光に対し高い透過率、 すなわち光透過性を有し、配母層の配母時の選 度に対し耐熱性を有し、熱伝導度が高く断熱効果 を有する材料層、例えば Se . 8 系の材料、すなわ ち Se . 8 の何れかを 40 原子%以上含む、例えば CuSe , As 2 Se 3 等を 300 Å以上の厚さを有し、更 にその厚さが干渉効果によつて高い透過率を示す 厚さに選定される。この場合、基体的は、例えば 1.2 至という大なる厚さに選ばれているので、干

(3)

第5 図中曲線(16)は、PMMAより成る基体(11)上にSe 膜より成る断熱材層(13を被着し、これの上に400%の厚さのTe 膜より成る情報配母層(13を被着して成る本発明の情報配母媒体の、Se 断熱材層(13)の厚さに対する8000%の波長の半導体レーザー光の反射率の測定結果で、これにより、Se 断熱材層(3)の厚さが600%、1800%程度のとき、低い反射率を示していることがわかる。そしてこの厚さは、断熱効果を奏する範囲でできるだけ得い方が望ましくこれがためSe 断熱材層(3)は、600%に選ぶ。

尚、第6図中曲線のは、8e断熱材層はのみを PMMA基体(1)上に単層に被着した場合の被長8000Å のレーザー光に対する透過率の測定結果を示すも のであり、との Se 断熱材層の自体は高い透過率を 有しているととがわかる。

上述したように本発明による情報配録媒体は基体(1)上に断熱材層(3)を介して溶融によつて配像ピットが形成される配録層(2)を形成するようにしたとにより、配録層(2)への例えば半導体レーザーの照射によつて記録すなわち溶融を行うに厳し、

多効果を生じることはないものであり、上述したように基体(I) 側からその配録光の照射を行つたり、 或いは読み出し光の照射を行う場合にはこれらの 光に対し透明度の高い材料を選定する。

第3図中曲線(14) は、PMMAより成る基体(1)上にAs2Se3 膜より成る断熱材層(13を被着し、これの上に400%の厚さのTe 膜より成る情報配録層(12を被着して成る本発明の情報配録媒体の、As2Se3 断熱材層(13の厚さに対する8000%の波長の半導体レーザー光の反射率の測定結果で、これにより、As2Se3断熱材層(13の厚さが500%,1800%程度のとき、低い反射率を示しているととがわかる。そしてこの厚さは、断熱効果を奏する範囲でできるだけ薄い方が望ましくこれがためAs2Se3 断熱材層(13は、500%に選ぶ。

尚、第4 図中曲線65 は、As 2 Se 3 断熱材層63のみを P M M A 基体611上に単層に被着した場合の放長 8000 Åのレーザー光に対する透過率の測定結果を示すものであり、この As 2 Se 3 断熱材層63 自体は高い透過率を有していることがわかる。

[4]

その熱によつて基体則を変形するととなく、また これにより配録ピットの形状が乱れたりするを効 果的に回避でき、SN比の高い記録を行うことが できる。また断熱材層のを設けたととによつて配 録時にその熱が基板似に放散するを効果的に回避 するととができるので配録パワーの低級化をはか るととができる。そして、との断熱材層G3の厚さ は、干渉効果によつて低い反射率を示す厚さに選 定することによつて基体の偶から配録光の無射を 行り場合においても断熱材層はを設けたことによ る記録パワーの増大を回避できる。因みに、断熱 材層はが設けられていたい従来の帮敲記録型の媒 体を用いた場合、記録光としての半導体レーザー は 10mw のものを用いる必要があつたものを、本 発明によるそれは 6 mw となし得、従来のそれの 30 ~ 40%低いエネルヤーでの配録が可能となつた。

尚、本発明による記録媒体からの情報の説予出しは、通常のように例えば記録時より低いパワーの半導体レーザーによつて記録ピットと他部にかける深さないしは厚さの差、或いは透過率もしく

は反射率の差を検出してその読み出しを行う。

せた、配保光或いは飲み出し光の媒体に対する 照射は、基体(I) 個とは反対個から行うこともできる。

図面の簡単な説明

2

ζ

Ł

藢

鷝

2Se2

=

8

み

を

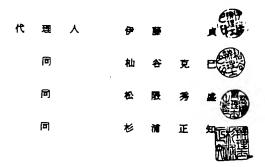
髙

ċ

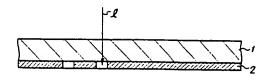
¥

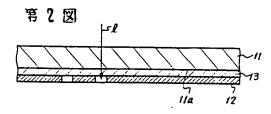
۴ 0 第1 図及び第2 図は夫々本発明による情報記録 供体の各例を示す断面図、第3 図及び第5 図は夫 夫本発明による情報記録供体の各例の断熱材層の 厚さと光透過率との関係を示す測定曲線図、第4 図及び第6 図は夫々その断熱材層の単層における 光透過率の測定曲線図である。

(1)は落体、0.2 は記録層、03は断熱材層である。

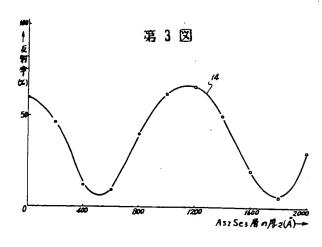


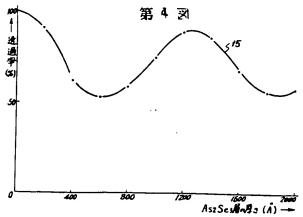
第 1 図



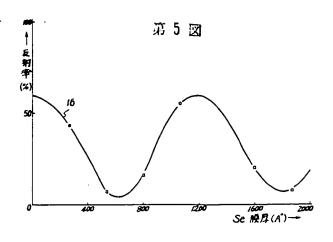


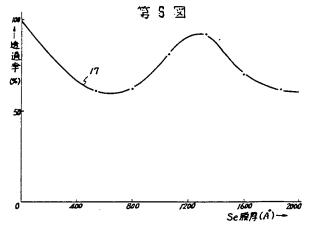
(7)





!





手 続 補 正 書

昭和56年7月9日

特許庁長官 島 田 春 樹 股高 (特許庁審判長 殿)

1. 事件の表示

昭和 56 年特許願第 72647 号

- 2. 発明の名称 情報記録媒体
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都品川区北品川6丁円7番35号名称 (218) ソニー 株式会社 代表取締役 岩 間 和 夫

4. 代 理 人 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 (新宿ビル) TE1.東京(03)343-5821 (代表)

(3388) 井理士 伊 藤

融

- 5. 補正命令の日付
- 昭和 年 月
- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補 正 の 対 象 明細書の発明の詳細な説明の欄

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.